

**ФАНО РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ СИЛЬНОТОЧНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИСЭ СО РАН)**

ПРИКАЗ

от « 01 » декабря 2016 г.

№ 151

Томск

**Об утверждении Положения об
антикоррупционной политике в
ИСЭ СО РАН**

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях противодействия коррупции, а также осуществления мероприятий, направленных на реализацию антикоррупционной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук и ввести его в действие с 01 декабря 2016 года.
2. Кадровой службе при приеме на работу в ИСЭ СО РАН доводить до сведения под роспись Положение об антикоррупционной политике в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук.
3. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений заместителя директора по научной работе Турчановского И.Ю.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Института

Н. А. Ратахин

Н.А. Ратахин

РАЗВЕРСТКА:

Структурное подразделение	Кол-во экз.
1. Канцелярия	1
2. Заместители директора по научной работе	2
3. Заместитель директора по производственной работе	1
4. Кадровая служба	1
5. ПЭО	1
6. Бухгалтерия	1
7. ОЗТРУ	1
Итого:	8

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по НР



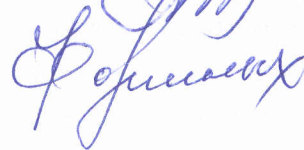
И.Ю. Турчановский

Ведущий юрисконсульт



Т.Н. Романова

Зав. канцелярией



И.В. Фоминых